









	<h2 style="color: #E67E22;">IPI030N10N3GXKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI030N10N3GXKSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 100A</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPI030N10N3GXKSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI030N10N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 275µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14800pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	206nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPI030N10N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI030N10N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI030N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI030N10N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI032N06N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI030N10N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI034NE7N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI024N06N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A</p>
 <p>IPI033NE7N INFINEON IPI033NE7N INFINEON</p>	 <p>IPI028N08N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI032N06N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A</p>	 <p>IPI024N06N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI030N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI030N10N3GXKSA1 Datenblatt	IPI030N10N3GXKSA1-Datenblätter	IPI030N10N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI030N10N3GXKSA1
IPI030N10N3GXKSA1 Electronic	IPI030N10N3GXKSA1-Komponenten	IPI030N10N3GXKSA1-Verteiler	IPI030N10N3GXKSA1-Bild	IPI030N10N3GXKSA1-Teil
IPI030N10N3GXKSA1 Preis	IPI030N10N3GXKSA1 Hersteller	IPI030N10N3GXKSA1 Bild	IPI030N10N3GXKSA1 Aktie	IPI030N10N3GXKSA1 Inventar
IPI030N10N3GXKSA1 Neu	IPI030N10N3GXKSA1 Original	IPI030N10N3GXKSA1 garantiert	IPI030N10N3GXKSA1 RFQ	IPI030N10N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited